科学研究費補助金研究成果報告書

平成23年 5月27日現在

機関番号:14301
研究種目:基盤研究(B)
研究期間:2008~2010
課題番号:20360315
研究課題名(和文)局所構造改質による酸化物ガラス内部への三次元シリコン構造体形成と新
機能発現
研究課題名(英文) Formation and new functions of three-dimensional Si structure in
silicate glasses by local structural modification
研究代表者
三浦 清貴(MIURA KIYOTAKA)
京都大学・大学院工学研究科・教授
研究者番号:60418762

研究成果の概要(和文):フェムト秒レーザー照射によるガラス内部からのSi析出を試み,金属 Al を添加したシリケートガラスにおいてレーザー照射と熱処理とを組み合わせることでミクロンオーダーのSi析出が可能であることを確認した.これらのガラスにおいては,ガラス形成酸化物がSiO2のみの場合に比べ,析出したSi周辺のガラス構造が破壊されにくい傾向にあることも確認できた.以上の結果は,酸化物ガラス内部にレーザー照射によちガラス構造を脆弱させることなくSi構造体が形成できる可能性を示唆する.また,照射するレーザーの空間モード,パルスエネルギー,繰り返し周波数,パルス幅および集光する対物レンズを調整することで,数ナノメートルサイズのSiナノ微粒子がレーザー集光点近傍のみに析出することをFE-SEM,TEM および顕微ラマン分光の結果より確認した.Siナノ粒子の析出はレーザー集光照射によるSiの集光点への移動(高濃度化)とともにレーザーによりSi-O 結合が切断され,O がAl に補足されることでSi 同士のクラスター化が促進された結果と考えられる.Siをはじめとする半導体ナノ粒子は量子サイズ効果により粒径を制御することで新しい形態の発光素子としての応用が期待できる.

研究成果の概要(英文): Mixing metallic Al into the starting material for silicate glass is proposed as a means of forming Si structures in glass. We confirmed that Si nanocrystals are space-selectively deposited in silicate glass via a thermite reaction triggered by femtosecond laser pulses. Small Si particles were transformed into larger, but still micrometer sized, Si particles by laser irradiation. These structures grew to micro-size particles due to the thermite reaction promoted by heat treatment. We discuss what effect the irradiation of the focused laser pulse had on the Si deposition process in the laser-irradiated region. Localized high temperatures and pressures and generation of shock waves appear to be very important in forming Si-rich structures that contribute to the growth of Si particles. The diffusion of calcium ions by the generation of shock waves and the presence of Al-rich structures is important for forming Si-rich structures such as Si clusters, which is achieved by continuously breaking Si-O bonds using localized high temperatures. These findings have opened up new possibilities in the field of Si-integrated devices and Si photonics.

			(金額単位:円)
	直接経費	間接経費	合 計
2008年度	7, 500, 000	2, 250, 000	9, 750, 000
2009年度	4, 300, 000	1, 290, 000	5, 590, 000
2010年度	2, 500, 000	750, 000	3, 250, 000
総計	14, 300, 000	4, 290, 000	18, 590, 000

交付決定額

研究分野:工学 科研費の分科・細目:材料工学・構造・機能材料 キーワード:新機能材料、レーザープロセッシング

1. 研究開始当初の背景

フェムト秒レーザーは, 集光照射すること で非常に高いピークパワーを容易に得るこ とができ,更にそのエネルギーがフェムト秒 オーダーの非常に短時間でガラスに吸収さ れ熱伝導や膨張によるエネルギー損失を伴 わないことから、レーザーの波長に対して透 明な材料においても通常の光相互作用では 起こりえない反応を起こさせることができ る.申請者らは、この事実をいち早く発見、 解明する過程においてフェムト秒レーザー パルスとガラス材料との相互作用の結果と して生じる屈折率変化,イオンの価数変化, 金属、半導体や非線形結晶の析出等、種々の 光誘起現象を観測し,基礎研究と同時に光誘 起現象により得られた個々の光誘起構造に ついて三次元光回路、回折光学素子、三次元 高速大容量光メモリー、高速光スイッチ、高 効率波長変換素子等への応用検討を実施し てきた.申請者らのゴールは、これらの機能 を同一ガラスチップ内に集積化し、複数の機 能を組み合わせたコンパクトなマルチ機能 光デバイスの実現であり、個々の光機能をコ ンパクトサイズで複合化するためには、可能 な限り小さいサイズにおいて、光の合分波、 進行方向、モード、波長、位相、振幅や偏波 制御が可能な機能を有する光誘起構造体の 形成が必要である.これらの機能をできるだ け狭い空間において高効率に発現させるた めには、できるだけ大きな屈折率差を有する 材料同士を組み合わせることが好ましい. そ こで、ガラス材料内部に母体となるガラスの 二倍以上の屈折率を有するサブミクロンか らミクロンオーダーのサイズの構造体形成 (誘起)について検討を開始した.その結果、 原料に金属A1を添加した無色透明ガラス を新たに研究開発し、その内部にフェムト秒 レーザーを集光照射することで、レーザーに よる高電場をトリガーとしてガラス内部で テルミット反応を誘発させ、局所領域におけ る Si ナノ微粒子や Si 構造体の析出・成長に よる三次元 Si 構造体の形成を実施した.

2. 研究の目的

Si は酸素に次いで多い元素であり、最もポ ピュラーな半導体材料であるとともに、石英 ガラスのような酸化物ガラスに比べ高い屈 折率を有している (Si:n=3.35、SiO2:n=1.47). 加えて、Si は光通信帯域の波長($1.3 \mu m$, $1.55 \mu m$)を透過する.この特性を利用すれ ば、透明ガラス内部へのSi フォトニック結晶 や Si 細線導波路形成が可能となり、フォトニ ック結晶による光

の制御と細線導波路によるミクロンオーダ ーでの光の三次元空間的な取り回しが可能 となり、ガラス材料への高機能性付与と光素 子のコンパクト化が期待できる.また、Si以 外にも Ge や化合物半導体等への適用が期待 でき、ガラスの基本骨格を光還元し半導体化 するという本課題は、応用面以外においても 基礎科学研究としても非常に興味深く、研究 の推進は有意義であると考えられる.また、 異種機能を有する素子の三次元的実装(三次 元ハイブリッド集積)と複数素子の三次元的 集積(三次元モノリシック集積)による新し い形態の三次元光・電子集積デバイス創製へ と繋がることも期待できる.

3. 研究の方法

ガラス内部の三次元 Si 構造体形成による 機能性光・電子材料の創製においては、ま ず、そのメカニズムを明らかにする必要があ る.メカニズムの解明においては、既に石英 系ガラス内部での Si 析出が確認されている 金属A1添加ガラスを中心に、フェムト秒レ ーザー集光照射前後におけるガラス状態の 詳細なデータを取得・解析し、金属A1添加 が Si 析出に及ぼす効果を明らかにする.同時 に、Si 構造体による細線導波路やフォトニッ ク結晶の作製において不可欠となるサイズ、 形状や形態の制御についても検討を行う必 要がある.

(1)Si 析出のメカニズム解明

金属A1を添加していない石英あるいは 石英系ガラスへのフェムト秒レーザー集光 照射では、Si の析出を確認することができな い.サブミクロンからミクロンサイズのSi を透明ガラス内部に析出させるためには、ガ ラス原料への還元剤(金属A1等)の添加、 フェムト秒レーザー照射及び熱処理が必要 であることが現在までにわかっている.金属 A1の添加とフェムト秒レーザー照射によ って、 石英系ガラス内部に Si リッチ領域 (≡ Si-Si≡、≡Si-Si=Si≡、Si クラスター 等)が形成されることが考えられるが、これ らの存在を示す明らかなデータは得られて いない. 本課題ではこれまでの研究を通して 得られた結果をもとに、ガラス基本骨格であ るSi0。の還元によるSi化及びSi成長のメカ ニズムの解明を図った.

(2)サイズ、形状および形態の制御 Si 細線導波路やフォトニック結晶をガラ ス内部に構築するためには、サイズ・形状の 制御と任意の構造体(周期構造等)の形成が 必要不可欠である.また、析出する Si の形 態(多結晶、単結晶や非晶質)はレーザー照 射条件に依存する可能性があり、析出条件と 形態との関係を明らかにする必要もある.そ こで、次の二点を中心に検討を進める.Ⅰ: 制御可能なガラス材料探索と組成の最適化、 Ⅱ:サイズ・形状へのレーザー照射条件の依 存性把握とその最適化を実施した.

4. 研究成果

Si 析出メカニズムを明らかにするため、フ ェムト秒レーザー集光照射における構造変 化のピコ秒~ナノ秒領域における動的過程 (ダイナミクス)をポンプープローブ法の一 種である過渡レンズ法を利用して観測・シミ ュレーションすることで、フェムト秒レーザ 一内部加工の特徴を調べた.図1は石英ガラ スに異なるエネルギーのレーザーパルス (200 fs、780 nm)を 20 倍の対物レンズで 集光照射した照射領域にプローブ光を入射 して得られた過渡レンズ信号である.フェム ト秒レーザーをガラス内部に集光照射する と、集光点付近では光イオン化によって生じ たプラズマの消失によって温度が急激に上 昇する.パルスエネルギーが大きい程より急 激な温度上昇が起こり、集光点に大きな熱歪 みを生じさせ、この歪みの緩和過程における 密度分布が図1の過渡レンズ信号振動を引 き起こすと考えられる.





図 2 はプローブ光の強度分布 $I_{SIG}(x',y')$ から位相分布 $\Delta \phi(x,y)$ の時間変化を解析した結果であり、 $\Delta \phi > 0$ が屈折率の上昇に対応する.この結果から、レーザー照射直後に集光 点中心の屈折率が減少し、100 ps から 200 ps にかけて中心から 2 μ m 付近に屈折率上昇領 域が認められ、その後徐々に高屈折率化領域 が中心から周囲に向かって同心円状に伝搬 し、400 ps 以降はガラスの音速に近い 6

µm/ns (6 km/s) で圧力波として伝播するこ とが確認できる.図1の過渡レンズ信号の振 動はこの圧力波の発生・伝搬により説明する ことができる. 振動の原因はレーザー照射領 域中心の屈折率分布の変化に起因している のではなく、圧力波によって生じたリング状 の高屈折率領域が移動することで、中心での 光の干渉が変化するためである.また、パル スエネルギーが大きくなるに従い振動強度 が大きくなるのは、圧力波の幅と強度が励起 光強度に依存して大きくなることを意味し ており、2000 ps 以降に振動成分が観測され なくなるのは、そこで構造変化が完了するの ではなく圧力波の伝搬速度から 2000 ps 以降 は圧力波がプローブ光の観測範囲外(12 µm 以上)に到達してしまうためである.ナノ秒 レーザーパルスでは、圧力波が伝播する時間 よりもはるかに遅い速度で熱歪みが生じる ことになるため、大きな熱歪みが形成される 前に応力緩和がほとんど終わってしまい、ガ ラスの破壊を伴わずに圧力波を発生させる ことは困難である.一連の実験とシミュレー ションから、パルスエネルギー:0.2 μJ、パ ルス幅: 200 fs、波長: 780 nm のレーザーを 20 倍の対物レンズを通して1パルス集光照 射することで、焦点中心の温度は半径 1 μm の領域において1 ps 以内に数千 K 以上に、 圧力は 1 GPs 程度まで上昇することも確認 しており、ガラス内部での瞬間的な高温・高 圧状態実現による圧力波発生が、Si 析出のド ライビングフォースと考えられる.



図2 プローブ光の強度分布から求めた位相分布の 時間変化

この現象を利用し、Si0₂系ガラスに出発 原料として金属アルミニウムを添加した無 色透明のガラスにフェムト秒レーザーを集 光照射することで、元素移動により中心領域 のSi元素濃度を高くすると同時にSi-0が切 断され、0イオンがA1の酸化により補足され ることでSiが凝集析出させることが可能で あることを確認した.このSiナノ粒子や構 造体は、レーザーによるSiの移動とともに レーザーによりSi-0結合が切断され、0が A1 に補足されることで Si 同士のクラスター 化が促進された結果と考えられる.半導体ナ ノ粒子は量子サイズ効果により粒径を制御 することで可視域において発光することが 知られており、ガラス材料の優れた成形性と 組み合わせることで新しい形態の発光素子 が開発できる可能性がある.SiO₂-B₂O₃系ガラ スや Si0,-P,0, 系ガラスにおいてもレーザー 照射と熱処理とを組み合わせることでミク ロンオーダーの Si 析出が可能であることを 確認した.従来は、ガウシアンビームを対物 レンズを通して集光照射することで、Si 析出 領域を形成したが、将来的に微細なパターン や周期構造、あるいは三次元構造体の形成を 高速・高精度で実施可能とするために、空間 位相変調素子(LCOS-SLM)を波面制 御モジュールとして利用するホログラフィ ックフェムト秒レーザー加工システムを構 築した. SLM に入力するホログラムは、形成 したい任意のパターンを表すビットマップ ファイルを用いて、フーリエ反復法による数 値計算により得た.結果、レーザービームの 形状(強度分布)や複数(100点以上)ビ ームへの分割が制御可能となり、複雑な形状 や周期構造を、レーザービームやステージを 移動させることなく形成することが可能と なった. さらに、フレネルレンズをCGH (Computer Generated Hologram)に組み込む ことで、Z軸方向においてもステージを稼働 させることなく一括加工することもできた. このシステムを用いて Si のパターンニング を実施した.加えて、レーザーエネルギーに よる Si-0 結合切断とイオンの拡散現象を利 用したシリコン析出に加え、Si 析出よりも低 いエネルギー密度で Ge や CdSe 等の半導体ナ ノ微粒子あるいは Au や Ag 等の金属ナノ微粒 子が析出可能であることも確認した。

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計12件)

- T. Matsuoka, M. Nishi, <u>Y. Shimotsuma</u>, <u>K. Miura</u>, K. Hirao, "Selective growth of gold nanoparticles on FIB-induced amorphous phase of Si substrate", J. Ceram. Soc. Jpn., 査読有, 118, **2010**, 575-578.
- M. Shimizu, <u>K. Miura</u>, M. Sakakura, M. Nishi, <u>Y. Shimotsuma</u>, <u>S. Kanehira</u>, T. Nakaya, K. Hirao, "Space-selective phase separation inside a glass by controlling compositional distribution with femtosecond laser irradiation", Appl. Phys. A, 査読有, 100, **2010**, 1001-1005.

- Y. Shimotsuma, M. Sakakura, P. G. Kazansky, M. Beresna, J. Qiu, <u>K. Miura</u>, K. Hirao, "Ultrafast Manipulation of Self-Assembled Form Birefringence in Glass", Adv. Mater., 査読有, 108, **2010**, 073533-1-10.
- S. Zhou, N. Jiang, <u>K. Miura</u>, S. Tanabe, M. Shimizu, M, Sakakura, <u>Y.</u> <u>Shimotsuma</u>, M. Nishi, J.g Qiu, K. Hirao, "Simultaneous Tailoring of Phase Evolution and Dopant Distribution in the Glassy Phase for Controllable Luminescence", J. Am. Chem. Soc., 査読有, 132, **2010**, 17945-73952.
- M. Shimizu, M. Sakakura, M. Ohnishi, <u>Y. Shimotsuma</u>, T. Nakaya, <u>K. Miura</u>, K. Hirao, " Mechanism of heat-modification inside a glass after irradiation with high-repetition rate femtosecond laser pulses", J. Appl. Phys., 査読有, 108, **2010**, 073533-1-10.
- M. Sakakura, M. Terazima, <u>Y.</u> <u>Shimotsuma</u>, <u>K. Miura</u>, K. Hirao, "Elastic and thermal dynamics in femtosecond laser-induced structural change inside glasses studied by the transient lens method", Laser Chem., 査読有, 2010, **2010**, 128268-1-15.
- S. Kanehira, M. Sakakura, Y. <u>Shimotsuma</u>, M. Eida, <u>K. Miura</u>, K. Hirao, "Phase control on iron silicieds using femtosecond laser irradiation", Appl. Phys. A, 査読有, 101, 2010, 81-85.
- M. Sakakura, T. Sawano, <u>Y.</u> <u>Shimotsuma</u>, <u>K. Miura</u>, K. Hirao, "Fabrication of three-dimensional 1 x 4 splitter waveguides inside a glass substrate with spatially phase modulated laser beam", Opt. Express, 査読有, 18, **2010**, 12136-12143.
- M. Sakakura, T. Sawano, <u>Y.</u> <u>Shimotsuma</u>, <u>K. Miura</u>, K. Hirao, "Parallel Drawing of Multiple Bent Optical Waveguides Using a Spatial Light Modulator", Jpn. J. Appl. Phys., 査読有, 48, **2009**, 126507-1-5.
- Y. Liu, M. Shimizu, B. Zhu, Y. Dai, B. Qian, J. Qiu, <u>Y. Shimotsuma</u>, <u>K. Miura</u>, K. Hirao, "Micromodification of element distribution in glass using femtosecond laser irradiation", Opt. Lett., 査読有, 34, **2009**, 136-138.
- Y. Liu, M. Shimizu, X. Wang, B. Zhu, M. Sakakura, <u>Y. Shimotsuma</u>, J. Qiu, <u>K. Miura</u>, K. Hirao, "Confocal Raman

imaging of femtosecond laser induced microstructures in germanate glasses", Chem. Phys. Lett., 査読有, 477, **2009**, 122-125.

<u>K. Miura</u>, K. Hirao, <u>Y. Shimotsuma</u>, M. Sakakura, <u>S. Kanehira</u>, "Formation of Si structure in glass with a femtosecond laser", Appl. Phys. A, 查 読有, 93, **2008**, 183-188.

〔学会発表〕(計16件)

- 松岡智代、西正之、坂倉政明、三浦清貴、 平尾一之、D. Palima、S. Tauro、A. Bañas、J. Glückstad. Manipulating functionalized 2PP structures on the BioPhotonics Workstation、Photonic West 2011、2011/1/27、米国・サンフラ ンシスコ
- 西村将和、<u>兼平真悟</u>、坂倉政明、<u>下間靖</u> <u>彦、三浦清貴</u>、平尾一之. Formation of Silicon and Silicon-based Semiconductor Materials via Photoinduced Reaction Using Femtosecond Laser、2010 MRS Fall Meeting、2010/11/30、米国・ボストン
- 松岡智代、西正之、坂倉政明、<u>下間靖彦</u>、 <u>三浦清貴</u>、平尾一之. Selective Growth and SERS Property of Gold Nanoparticles on Amorphized Silicon Surface、3rd International Congress on Ceramics、2010/11/16、大阪国際会議場
- 坂倉政明、清水雅弘、<u>下間靖彦、三浦清</u> <u>貴</u>、平尾一之. Fundamental studies of heat modification inside glasses by repeated irradiation with ultrashort laser pulses、International Conference FLAMN-10、2010/7/6、ロシア・サンク トペテルブルグ
- <u>三浦清貴</u>、清水雅弘、<u>下間靖彦</u>、坂倉政 明、<u>兼平真悟</u>、平尾一之. Formation Mechanism and applications of laser induced elemental distribution in glasses 、 The 17th International Symposium on Non-Oxide and New Optical Glasses、2010/6/13、中国・ Ningbo
- <u>三浦清貴</u>.フェムト秒レーザー材料加工 の特徴とホログラフィック加工、第3回 ガラス科学技術研究会、2009/12/10、日 本・東京
- 清水雅弘、三浦清貴、保田直美、坂倉政 明、<u>兼平真悟</u>、西正之、<u>下間靖彦</u>、平尾 一之. Migrating element in glass with laser irradiation、MRS 2009 Fall Meeting、2009/12/2、米国・ボストン
- 8. <u>三浦清貴</u>. Formation of elemental distribution in glass with a

femtosecond laser、10th International Conference on Laser Ablation、2009/11/24、シンガポール

- 9. <u>三浦清貴</u>.フェムト秒レーザーガラス材 料プロセッシングの特徴と可能性、第50 回ガラスおよびフォトニクス材料討論 会、2009/10/30、京都大学
- 西村将和、<u>兼平真悟</u>、坂倉政明、<u>下間靖</u> <u>彦、三浦清貴</u>、平尾一之.光誘起反応に よるガラス界面への Si 結晶析出、第 50 回ガラスおよびフォトニクス材料討論 会、2009/10/29、京都大学
- <u>下間靖彦</u>、坂倉政明、三浦清貴、平尾一之. 偏光依存酸素欠陥構造の超高速制御、 2009 年秋季第70 回応用物理学会学術講 演会、2009/9/8、富山大学
- 12. 松岡智代、西正之、<u>下間靖彦、三浦清貴</u>、 平尾一之. FIB で加工した金ナノ粒子の 自己組織的成長、2009 年秋季第 70 回応 用物理学会学術講演会、2009/9/8、富山 大学
- 13. <u>下間靖彦</u>、坂倉政明、<u>三浦清貴</u>、平尾一 之、邱建栄、Peter G. Kazansky. Ultrafast switching of nanostructure in fused silica、Nanotech Insight 2009、 2009/3/31、スペイン・バルセロナ
- 14. 保田直美、清水雅弘、坂倉政明、<u>下間靖</u> <u>彦、三浦清貴</u>、平尾一之.フェムト秒レー ザーによる熱蓄積効果を利用したガラ ス内部への元素分布形成①、日本セラミ ックス協会 2009 年年会、2009/3/18、東 京理科大学
- 15. 清水雅弘、坂倉政明、<u>下間靖彦、三浦清</u> <u>貴</u>、平尾一之.フェムト秒レーザーによる 熱蓄積効果を利用したガラス内部への 元素分布形成②、日本セラミックス協会 2009 年年会、2009/3/18、東京理科大学
- 下間靖彦、坂倉政明、三浦清貴、平尾一 之.フェムト秒レーザーによるガラス内 部の偏光依存ナノ構造制御、レーザー学 会学術講演会第 29 回年次大会、 2009/1/12、徳島大学

〔図書〕(計2件)

- 三浦清貴、下間靖彦、坂倉政明、平尾一 之、㈱エヌ・ティー・エス、セラミック 機能化ハンドブック、2010、120-150.
- <u>下間靖彦、三浦清貴</u>、平尾一之、シーエムシー出版、最先端高密度配線銅めっき技術、2009、221-236.

〔産業財産権〕 〇出願状況(計4件)

名称:配線導体の形成方法および配線基板 発明者:福島俊彦、吉田幸治、山名毅、渡辺 静晴、川上章彦、平尾一之、<u>三浦清貴、下間</u> 靖彦、坂倉政明、兼平真悟 権利者:株式会社村田製作所 種類:特許 番号:特許公開 2010-192786 出願年月日: 2009年2月20日 国内外の別:国内 名称:レーザ光照射装置及び照射方法 発明者:坂倉政明、平尾一之、<u>三浦清貴、下</u> 間靖彦、福智昇央、伊藤晴康 権利者:浜松ホトニクス株式会社 種類:特許 番号:特許公開 2010-184265 出願年月日: 2009年2月12日 国内外の別:国内 名称:配線導体の形成方法および配線基板 発明者:吉田幸治、福島俊彦、山名毅、渡辺 静晴、川上章彦、平尾一之、<u>三浦清貴、下間</u> 靖彦、坂倉政明、兼平真悟 権利者:株式会社村田製作所 種類:特許 番号:特許公開 2010-186842 出願年月日:2009年2月12日 国内外の別:国内 名称:組成分布を生じる光学部品用透明材料 及びこれを利用する光学部品 発明者:<u>三浦清貴、下間靖彦</u>、平尾一之、富 田礼子、田中修平、橋本智弘、山口勝彦 権利者:京都大学、田中修平、株式会社オハ ラ 種類:特許 番号:特許公開 2010-70399 出願年月日:2008年9月16日 国内外の別:国内 [その他] 6. 研究組織 (1)研究代表者 三浦 清貴 (MIURA KIYOTAKA) 京都大学・大学院工学研究科・教授 研究者番号:60418762 (2)研究分担者 下間 靖彦 (SHIMOTSUMA YASUHIKO) 京都大学・大学院工学研究科・准教授 研究者番号:40378807 (3) 兼平 真悟 (KANEHIRA SHINGO) 京都大学・学際融合教育研究推進センター 上席高度専門技術職 研究者番号: 30437248